

У П Р А Ж Н Е Н И Е №4

Изследване на генератор на ток за изпитания на NiMH акумулаторни батерии

Различните типове акумулаторни батерии имат параметри, които ги правят предпочитани за различни приложения. В този смисъл няма “най-добър” тип батерии – когато са предназначени за преносими апарати батериите трябва да са леки, когато са предназначени за продължителна експлоатация без надзор – да позволяват много цикли, когато са като резервно хранване – да се саморазреждат бавно и т.н. По тези въпроси има достатъчно материали:

<http://www.cewindows.net/battery.htm>

<http://www.thermoanalytics.com/support/publications/batterytypesdoc.html>

<http://www.batterysavers.com/Compare-Batteries.html>

При изпитания на батериите се изпълняват цикли на заряд и разряд като се измерва капацитета на NiMH батерии, проверяват се критериите за заряд и разряд.

Целта на лабораторното упражнение е да се изследва генератор на ток, който да бъде приложим за разряд на изпитваните батерии при цикличните изпитания.

Задачи:

1. Да се снее опитно схемата на генератора на ток със стойност 300 mA за разреждане на батерия от макета, който се хранва **САМО** от нейното напрежение (за два елемента то е от 1,8 до 3,5 V).

2. Да се симулира схемата с помощта на LTSPICE. Достатъчна е точност 2-5%.

3. Да се изследва изменението на тока при промяна на хранващото напрежение в диапазона от 1,8 до 3,5 V.

Указания:

На фиг. 1 е показана примерна блокова схема на генератор на ток, който е предназначен да разрежда акумулаторна батерия.

U_{bat} – напрежение на батерията

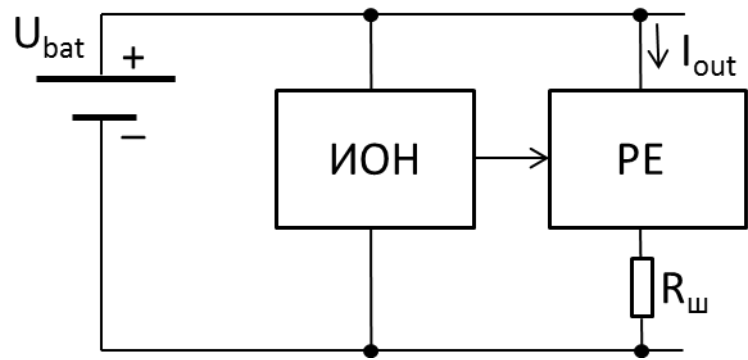
ИОН – източник на опорно напрежение

PE – регулиращ елемент

I_{out} – изходен ток

$R_{ш}$ – шунтов резистор

Генераторът на ток трябва да осигурява стабилен ток за целия диапазон на изменение на напрежението на батерията от 1,8 до 3,5 V. За целта се използва ИОН. Изходният ток I_{out} се определя от ИОН и $R_{ш}$. Регулиращият елемент PE трябва да издържа по ток с необходимия запас стойността на I_{out} и да поема изменението на напрежението.



фиг. 1

LM185-1.2/LM285-1.2/LM385-1.2

Micropower Voltage Reference Diode

General Description

The LM185-1.2/LM285-1.2/LM385-1.2 are micropower 2-terminal band-gap voltage regulator diodes. Operating over a 10 μ A to 20mA current range, they feature exceptionally low dynamic impedance and good temperature stability. On-chip trimming is used to provide tight voltage tolerance. Since the LM185-1.2 band-gap reference uses only transistors and resistors, low noise and good long term stability result.

Careful design of the LM185-1.2 has made the device exceptionally tolerant of capacitive loading, making it easy to use in almost any reference application. The wide dynamic operating range allows its use with widely varying supplies with excellent regulation.

The extremely low power drain of the LM185-1.2 makes it useful for micropower circuitry. This voltage reference can be used to make portable meters, regulators or general purpose analog circuitry with battery life approaching shelf life.

Further, the wide operating current allows it to replace older references with a tighter tolerance part.

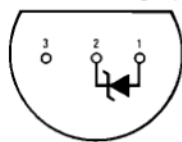
The LM185-1.2 is rated for operation over a -55°C to 125°C temperature range while the LM285-1.2 is rated -40°C to 85°C and the LM385-1.2 0°C to 70°C . The LM185-1.2/LM285-1.2 are available in a hermetic TO-46 package and the LM285-1.2/LM385-1.2 are also available in a low-cost TO-92 molded package, as well as SO and SOT-23. The LM185-1.2 is also available in a hermetic leadless chip carrier package.

Features

- $\pm 1\%$ and 2% initial tolerance
- Operating current of 10 μ A to 20mA
- 1 Ω dynamic impedance
- Low temperature coefficient
- Low voltage reference—1.235V
- 2.5V device and adjustable device also available
- LM185-2.5 series and LM185 series, respectively

Connection Diagrams

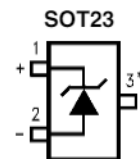
T0-92
Plastic Package (Z)



551810

Bottom View

Order Number LM285Z-1.2,
LM285BXZ-1.2, LM285BYZ-1.2
LM385Z-1.2, LM385BZ-1.2
LM385BXZ-1.2 or LM385BYZ-1.2
See NS Package Number Z03A

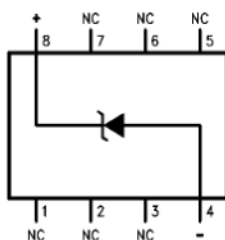


551833

* Pin 3 is attached to the Die Attach Pad (DAP) and should be connected to Pin 2 or left floating.

Order Number LM385M3-1.2
See NS Package Number MF03A

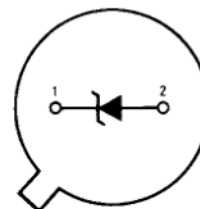
SO Package



551809

Order Number LM285M-1.2,
LM285BXM-1.2, LM285BYM-1.2
LM385M-1.2, LM385BM-1.2
LM385BXM-1.2 or LM385BYM-1.2
See NS Package Number M08A

TO-46
Metal Can Package (H)



551806

Bottom View

Order Number LM185H-1.2, LM185H-1.2/883,
LM185BXH-1.2, LM185BYH-1.2
LM285H-1.2 or LM285BXH-1.2
See NS Package Number H02A

Absolute Maximum Ratings (Note 1)

If Military/Aerospace specified devices are required, please contact the National Semiconductor Sales Office/Distributors for availability and specifications.

(Note 2)

Reverse Current	30mA
Forward Current	10mA
Operating Temperature Range (Note 3)	
LM185-1.2	-55°C to +125°C
LM285-1.2	-40°C to +85°C
LM385-1.2	0°C to 70°C

ESD Susceptibility (Note 9)

2kV

Storage Temperature

-55°C to +150°C

Soldering Information

TO-92 package: 10 sec.

260°C

TO-46 package: 10 sec.

300°C

SO and SOT Pkg.

Vapor phase (60 sec.)

215°C

Infrared (15 sec.)

220°C

See AN-450 "Surface Mounting Methods and Their Effect on Product Reliability" for other methods of soldering surface mount devices.

Electrical Characteristics (Note 4)

Parameter	Conditions	Typ	LM185-1.2 LM185BX-1.2 LM185BY-1.2 LM285-1.2 LM285BX-1.2 LM285BY-1.2		LM385B-1.2 LM385BX-1.2 LM385BY-1.2		LM385-1.2		Units (Limit)
			Tested Limit (Notes 5, 8)	Design Limit (Note 6)	Tested Limit (Note 5)	Design Limit (Note 6)	Tested Limit (Note 5)	Design Limit (Note 6)	
Reverse Breakdown Voltage	$T_A = 25^\circ\text{C}$, $10\mu\text{A} \leq I_R \leq 20\text{mA}$	1.23 5	1.223		1.223		1.205		V(Min)
			1.247		1.247		1.260		V(Max)
Minimum Operating Current	LM385M3-1.2	8	10	20	15	20	15	20	μA (Max)
Reverse Breakdown Voltage Change with Current	$10\mu\text{A} \leq I_R \leq 1\text{mA}$		1	1.5	1	1.5	1	1.5	mV (Max)
	$1\text{mA} \leq I_R \leq 20\text{mA}$		10	20	20	25	20	25	mV (Max)
Reverse Dynamic Impedance	$I_R = 100\mu\text{A}$, $f = 20\text{Hz}$	1							Ω
Wideband Noise (rms)	$I_R = 100\mu\text{A}$, $10\text{Hz} \leq f \leq 10\text{kHz}$	60							μV
Long Term Stability	$I_R = 100\mu\text{A}$, $T = 1000\text{Hr}$, $T_A = 25^\circ\text{C} \pm 0.1^\circ\text{C}$	20							ppm
Average Temperature Coefficient (Note 7)	$I_R = 100\mu\text{A}$ X Suffix Y Suffix All Others		30 50		30 50		150	150	ppm/ $^\circ\text{C}$ ppm/ $^\circ\text{C}$ ppm/ $^\circ\text{C}$ (Max)

Note 1: Absolute Maximum Ratings indicate limits beyond which damage to the device may occur. Operating Ratings indicate conditions for which the device is intended to be functional, but do not guarantee specific performance limits. For guaranteed specifications and test conditions, see the Electrical Characteristics. The guaranteed specifications apply only for the test conditions listed.

Note 2: Refer to RETS185H-1.2 for military specifications.

Note 3: For elevated temperature operation, T_J max is:

LM185	150°C
LM285	125°C
LM385	100°C